

用 表 须 知

- 1、本表可作为各类专家选拔、考核和管理用表。
- 2、本表作为专家数据库信息源，并作为各地区、各部门各类专家选拔、
管和管理 and 考核的存档材料。
- 3、表内项目本人没有的，一律置空。
- 4、表中各项要严格按照规定的字数填写，不得超长（详见填表说明）。
- 5、本表中所有标记、代码部分由人社（专家管理）部门授权专人统一
译码、填写。
- 6、单位指专家的具体工作单位。
- 7、类别指申报专家的类别。如享受政府特殊津贴
- 8、序号指申报同一类别专家的人选排序
- 9、填表前须认真阅读《填表说明》（附后）。

基本情况:

姓名	崔教林		证件类型	<input checked="" type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 护照	证件号码	110105196212125535	
性别	男	出生日期	1962.12	籍贯	浙江宁波	政治面貌	中共
民族	汉	文化程度	研究生	学位	博士	毕业时间	2002.06
毕业学校	浙江大学			所学专业	材料学		
从事专业	材料学	技术职称	教授	技术等级	3		
工作单位	宁波工程学院				参加工作时间	1988.04	
单位性质	公有经济事业	行业分类	制造业	在岗状态	一线应聘		
行政职务		职业资格	教师	手机号码	13586529768		
回国年份		何处归来		电子邮箱	cuijiaolin@163.com		
进博站年份		博导年份		邮政编码	315016		
专业技术工作经历							
<p>1992.5--1992.8: 受日本国际事业协力团赞助, 赴日本名古屋从事“High Technology Materials Application”项目;</p> <p>1993.9--1994.4: 受英国文化委员会(British Council)资助赴英国University of Newcastle Upon Tyne从事项目“Hydrogen Embrittlement in Various Steels”研究;</p> <p>1988.4--1999.9: 从事科研工作: “低合金钢缺口敏感性及在含氢环境中的脆性行为”主题研究;</p> <p>1999.9---2016.3: 从事新型热电材料合成、性能与应用主题研究;</p>							
学术组织任职情况							
<p>中国仪表功能材料学会理事</p> <p>中国表面工程学会理事</p> <p>中国材料研究学会热电材料应用技术分会理事</p> <p>中国材料研究学会高级会员</p> <p>宁波市材料研究学会常务理事</p>							

专业水平情况:

主要突出贡献事迹
<p>(350字以内, 主要为工作业绩、成果、效益、行业地位、专业获奖和荣誉情况概述)</p> <p>研究成果和行业地位:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) “低维或纳米结构结合最优元素掺杂协同调控材料热电性能”在国内外拥有明显的特色和优势;(2) “低维及纳米结构金属碲化物半导体器件的应用基础研究”赢得了同行的高度关注和重视;(3) “宽带隙半导体热电材料的制备和基础理论研究”在国内外享有较高的评价和地位。 <p>具体工作业绩和专业获奖等:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) 在国际刊物上发表了约70篇有关热电材料的研究论文。其中多篇论文发表在 <i>J. Mater. Chem. A,C</i>, <i>Appl. Phys. Lett.</i>, <i>Dalton Trans.</i> 等国际重要刊物上, 并赢得了同行的高度关注, 如被美国工程院院士 G.Chen, Kanatzidis 教授、意大利国家科学顾问 G. Cao、俄国科学家 Shevelkov、中国科学院 R.J.Huang、钱逸泰、葛昌纯院士等在国际权威杂志如 <i>Nano Lett.</i>, <i>Adv. Mater.</i>, <i>Adv. Func. Mater.</i>, <i>Mater. Sci. Eng. R</i>, <i>JACS</i>, <i>Small</i>, <i>ACS Nano</i>, <i>Chem. Rev.</i> 等中大篇幅引用报道;(2) 获得浙江省科学技术奖三等奖、宁波市科技进步二等奖各一项;(3) 在宽禁带热电半导体的制备领域拥有自主知识产权。
代表论文和著作(含专利)
<p>(填写10篇以内最能代表本人贡献和水平的论文、著作、译作、创作、设计、专利等, 注明发表的时间、刊物名称、期号、专利号等)</p> <ol style="list-style-type: none">1. J.Cui*, Y.Li, Z.Du, Q.Meng, H.Zhou, Promising defect thermoelectric semiconductor $\text{Cu}_{1-x}\text{GaSb}_x\text{Te}_2$ ($x=0-0.1$) with chalcopyrite structure, <i>J. Mater.Chem.A</i>, 2013, 1(3), 677.2. J.Cui*, L.Wang, Z. Du, P. Ying, Y.Deng, High thermoelectric performance of a defect $\alpha\text{-In}_2\text{Se}_3$-based solid solution upon Zn substitution for In, <i>J. Mater. Chem.C</i>, 2015, 3, 9069.3. J.Cui*, Y.Gao, H.Zhou, Y.Li, Q. Meng, J. Yang, Significantly enhanced thermoelectric figure of merit through Cu, Sb co-substitutions for Te in Ga_2Te_3, <i>Appl. Phys. Lett.</i>, 2012, 101(8), 081908.4. J.Yang, S.Chen*, Z.Du, X. Liu, J.Cui*, Lattice defects and thermoelectric properties: The case of p-type CuInTe_2 chalcopyrite by introduction of zinc, <i>Dalton Trans.</i>, 2014, 43(40), 15228.5. Y.Li, Q.Meng, Y.Deng, H. Zhou, Y.Gao, J.Cui*, High thermoelectric performance of solid solutions $\text{CuGa}_{1-x}\text{In}_x\text{Te}_2$ ($x = 0-1.0$), <i>Appl. Phys. Lett.</i>, 2012, 100(23), 231903.6. W. Wu, Y. Li, Z. Du, Q.Meng, Z. Sun, W. Ren, J.Cui*, Manipulation of the crystal structure defects: an alternative route to the reduction in lattice thermal conductivity and improvement in thermoelectric performance of CuGaTe_2, <i>Appl. Phys. Lett.</i>, 2013, 103, 0119057. H. Liu, D. Tian, Z. Du, J. Cui*, Coexisting transport behaviors in quasibinary $\text{Cd}_{(3-3m)}\text{Ga}_{2m}\text{Te}_3$ ($m = 0.75 - 0.98$) system with structural vacancy and cationic interdiffusion, <i>Scripta Mater.</i> 2016, 113, 194.8. D. Tian, H. Liu, Y. Deng, Z. Du, J.Cui*, Engineered cation vacancy plane responsible for the reduction in

lattice thermal conductivity and improvement in thermoelectric property of Ga₂Te₃ based semiconductors, *RSC Adv.*, 2014, 4(64), 34104.

9. 崔教林, 吴文昌, 热电半导体温度传感片的单臂结构及制备工艺, 国家知识产权局, ZL201310652532.9, 授权时间: 2015.12.2.
10. 崔教林, 李亚鹏, 具有黄铜矿结构的Cu-Ga-Sb-Te四元热电半导体及其制备工艺, 国家知识产权局, ZL201210335154.7, 授权时间: 2014.5.21.

本人保证以上所填内容属实。

签名:

年 月 日

所 在 单 位 意 见

盖 章

年 月 日

县(市)区人社部门或市级主管部门意见

盖 章

年 月 日

填 表 说 明

(不用报送)

- 1、姓名：用字要固定、规范，长度在 3—10 个汉字之间。
- 2、出生日期：用公历，用“—”分隔年、月、日，如 1986-03-01。
- 3、籍贯：只填至省、自治区、直辖市；
- 4、文化程度：国家承认的最高学历。
- 5、学位：国内外获得的最高学位。
- 6、毕业时间：最高学历毕业时间，填至月份
- 7、毕业学校：最高学历毕业学校。文化程度、学位、毕业时间和毕业学校应相互对应。
- 8、从事专业：指现正从事的专业。
- 9、工作单位：指申报人目前的工作单位名称。
- 10、参加工作时间：参加专业技术工作的起始时间，填至月，如 65.09。
- 11、单位性质：填写下列性质之一：
公有经济企业 / 公有经济事业 / 非公经济组织 / 社会组织 / 其它
- 12、在岗状态：选填下列几种状态之一：
一线应聘 退居二线但未离退 已办理退休手续 已办理离休手续
离退休后被返聘 停薪留职 已辞职 已去世
- 13、行政职务：指现正在担任的最高行政职务。高等院校行政职务只填至校系两级。
- 14、行业分类：参考信息采集软件中相关栏目，选填其中之一
- 15、联系电话：按地区号—电话号码形式填写，如 010—84220943
- 16、邮政编码：指工作单位的邮政编码。
- 17、回国年份：指曾在海外(含台、港、澳地区)定居的华裔专家归国工作的时间。含建国后从大陆出国留学、进修学成取得外国国籍或居住权的回国人员。
- 18、何处归来：应与回国年份相对应。
- 19、进博站年份：进博士后流动站或工作站从事博士后研究的年份
- 20、博导年份：被批准为博士生导师的年份。

- 21、主要专业工作经历：简要填写主要的专业技术工作经历。
- 22、学术组织任职情况：主要填写市级以上学术组织的担任职务和任职时间等情况
- 23、获奖情况：获奖只填写所获重要奖项，不超过 10 项，具体种类如下：国家自然科学奖 国家发明奖 国家科技进步奖 省部级奖 市地级奖 获奖等级和排名应按获奖证书的等级和排名填写，均要求以阿拉伯数字表示。其中没有等级的填写“9”，特等奖填写“0”，没有排名的填写“0”，本人单独承担或主持获奖项目的填写“1”。获奖项目名称应控制在 20 个汉字内，年度以公历表示，如 1993。
- 24、主要突出贡献事迹：限 350 个汉字，指人选作出的突出贡献、学术水平和取得的经济、社会效益。（详细事迹可另附）
- 25、代表论文和著作：填写最能代表本人贡献和水平的论文、著作、译作、创作、设计、专利等，注明发表的时间、刊物名称、期号、专利号等。